

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2012年3月8日(08.03.2012)



(10) 国際公開番号
WO 2012/029354 A1

- (51) 国際特許分類:
H03H 9/145 (2006.01) H01L 41/22 (2006.01)
H01L 41/09 (2006.01) H03H 9/17 (2006.01)
H01L 41/18 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/060316
- (22) 国際出願日: 2011年4月27日(27.04.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-195020 2010年8月31日(31.08.2010) JP
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 太陽誘電株式会社(TAIYO YUDEN CO., LTD.)
[JP/JP]; 〒1100005 東京都台東区上野6丁目16番20号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 松田聡(MATSUDA, Satoru) [JP/JP]; 〒1100005 東京都台東区上野6丁目16番20号 太陽誘電株式会社内 Tokyo (JP). 松田隆志(MATSUDA, Takashi) [JP/JP]; 〒1100005 東京都台東区上野6丁目16

番20号 太陽誘電株式会社内 Tokyo (JP). 三浦道雄(MIURA, Michio) [JP/JP]; 〒1100005 東京都台東区上野6丁目16番20号 太陽誘電株式会社内 Tokyo (JP).

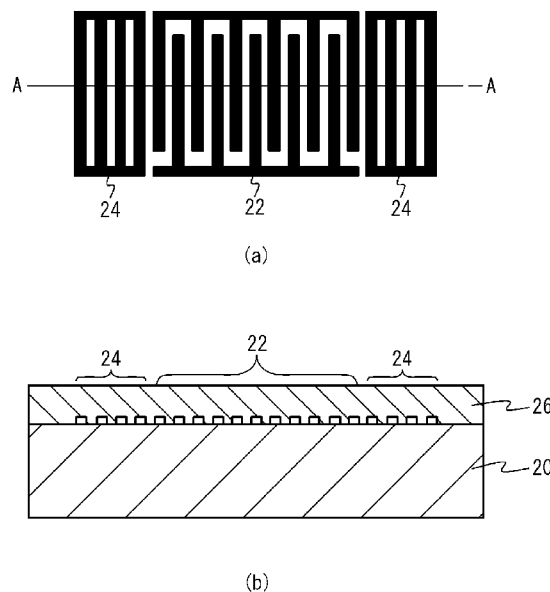
- (74) 代理人: 片山修平(KATAYAMA, Shuhei); 〒1040031 東京都中央区京橋1-6-1 三井住友海上テプコビル Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ

[続葉有]

(54) Title: ACOUSTIC WAVE DEVICE

(54) 発明の名称: 弾性波デバイス

[図5]



(57) Abstract: The present invention provides an acoustic wave device comprising: a piezoelectric substrate (20) or a piezoelectric film (34); electrodes (22, 32, 36) disposed on top of the piezoelectric substrate (20) or sandwiching the piezoelectric film (34); and a silicon oxide film (26, 38) with a doped element or molecule that replaces O in the Si-O bond, provided in a region wherein a lower electrode (32), which covers a comb-shaped electrode (22) disposed on the piezoelectric substrate (20) or sandwiches the piezoelectric film (34), and an upper electrode (36) face each other.

(57) 要約: 本発明は、圧電基板20または圧電膜34と、圧電基板20上または圧電膜34を挟んで設けられた電極22、32、36と、圧電基板20上に設けられた櫛型電極22を覆ってまたは圧電膜34を挟む下部電極32と上部電極36とが対向する領域に設けられた、Si-O結合におけるOと置換する元素又は分子がドーピングされたシリコン酸化膜26、38と、を備える弾性波デバイスである。



(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT,
NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR,
NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))